

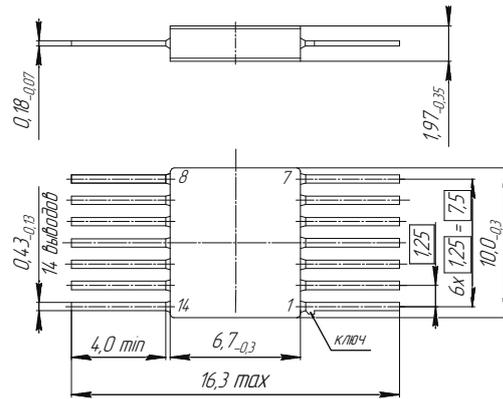


112ЛД1

БК0.347.077 ТУ

Три расширителя по "ИЛИ".

$T_{экспл}: -60^{\circ}\text{C} \dots +125^{\circ}\text{C}$



2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13	Входы
1, 7	Расширение по "И"
8, 10, 14	Расширение по "ИЛИ"
9	Напряжение питания

Металлостеклянный корпус 401.14-5М

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения при $T_{окр. ср.} = +25^{\circ}\text{C}$)	Буквенное обозначение	Значение параметров	
		не менее	не более
Входной ток логического нуля ($U_{и.п} = 3,3 \text{ В}$), мА	$I_{вх}^0$	0,6	1,05
Входной предельно допустимый ток ($U_{вх} = 4,5 \text{ В}$), мкА	$I_{вх пр-доп}$		3
Эмиттерный ток входного транзистора ($U_{и.п} = 2,7 \text{ В}$), мА	$I_{э}$	6	-
Импульсный эмиттерный ток, мА: - при длительности импульса 2,5 мкс; - при длительности импульса не более 1 мкс	$I_{эн}$	-	15 20
Максимально допустимая мощность рассеивания на корпусе микросхемы, мВт, при $T_{окр}$ до 100°C	P_{max}	-	100
Входное отрицательное напряжение (при напряжении на остальных входах не более +4,5 В), В	$U_{отриц}$	-	1

Возможна поставка в бескорпусном исполнении разделенными или не разделенными на кристаллы